

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์และออกแบบวงจรเลียนแบบอุปกรณ์โดยใช้ CCCCTA สำเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนะนำ ความคิดเห็น และกำลังใจแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มন্ত্রী ศิริปรัชญานันท์ ที่ได้ให้แนวคิด ความรู้ทางวิชาการ ตรวจสอบรายงานการวิจัยทุกขั้นตอน ตลอดจนคำแนะนำในการดำเนินชีวิต และกำลังใจแก่ผู้เขียนโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นผลให้ผู้เขียนมีความสามารถในการทำและพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่แก่ศิษย์ของผู้เขียนต่อไป

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจในการทำงาน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้สนับสนุนทุนในการทำวิจัยในครั้งนี้

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นกำลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดทำรายงานการวิจัย

วินัย ใจกล้า

พฤศจิกายน 2553

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	(1)
บทคัดย่อ	(2)
ABSTRACT	(3)
สารบัญ	(4)
สารบัญภาพ	(6)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 หลักการของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำ	4
2.2 วงจรสะท้อนกระแส	10
2.3 หลักการพื้นฐานของทรานส์ลีเนียร์	14
2.4 วงจรขยายคลาส AB แบบทรานส์ลีเนียร์รูป	17
2.5 วงจรขยายความนำถ่ายโอน	20
2.6 วงจรขยายส่งผ่านความนำสายพานกระแสที่ควบคุมด้วยกระแส	26
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	27
2.8 สรุป	31
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	32
3.1 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำ	32
3.2 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำอนุกรม กับตัวต้านทาน	34
3.3 การวิเคราะห์วงจรในกรณีไม่เป็นอุดมคติ	37
3.4 สรุป	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	42
4.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของวงจรเลียนแบบคูปกรณ์ ที่ได้ออกแบบไว้ในทางทฤษฎีกับการจำลองด้วยโปรแกรม PSpice	42
4.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของวงจรเลียนแบบคูปกรณ์ ที่ได้ออกแบบไว้ในทางทฤษฎีกับการทดลองต่อวงจรจริง	45
4.3 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรประยุกต์ใช้งาน วงจรเลียนแบบคูปกรณ์ในวงจรรองความถี่	48
4.4 สรุป	50
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	51
5.1 สรุปผล	51
5.2 ข้อเสนอแนะ	52
บรรณานุกรม	53
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบจำลองของไปโพลาร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัย	55
ภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์	56
ประวัติผู้ทำรายงานการวิจัย	65

สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 หลักการของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำ	5
2.2 โครงสร้างโดยทั่วไปของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำ	7
2.3 บล็อกไดอะแกรมของวงจรสะท้อนกระแส (ก) ชนิดบวก (ข) ชนิดลบ	10
2.4 วงจรสะท้อนกระแสแบบพื้นฐาน	11
2.5 วงจรสะท้อนกระแสแบบง่ายหลายขาออก	12
2.6 รูปแบบทั่วไปของวงจรทรานส์ลิเนียร์รูป	15
2.7 วงจรขยายคลาส AB แบบทรานส์ลิเนียร์รูป	18
2.8 สัญลักษณ์ของ OTA	21
2.9 วงจรสมมูลย์ทางอุดมคติของ OTA	21
2.10 วงจรขยายความนำถ่ายโอนชนิดใช้ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์อย่างง่าย	22
2.11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสจุดออกที่เป็นฟังก์ชันของแรงดันผลต่างของอินพุต	23
2.12 วงจรสมมูลย์ของ OTA ที่มีโครงสร้างแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์	25
2.13 CCCCTA (ก) สัญลักษณ์ (ข) วงจรสมมูล	26
2.14 วงจรเลียนแบบอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ใช้ DO-CCII จำนวนสองตัว	28
2.15 วงจรเลียนแบบอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ใช้ CCCII ร่วมกับอุปกรณ์พาสซีฟที่ต่อลงกราวนด์	28
2.16 วงจรเลียนแบบอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ใช้ CCII จำนวนสามตัว	29
2.17 วงจรเลียนแบบอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ใช้ CCII จำนวน 3 ตัวร่วมกับอุปกรณ์พาสซีฟที่ต่อลงกราวนด์	30
2.18 วงจรเลียนแบบอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ใช้ MCFOA	31
3.1 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำที่ต่อลงกราวนด์	32
3.2 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับตัวต้านทานแบบต่อลงกราวนด์	35
3.3 วงจรเทียบเคียงของ CCCCTA เมื่อพิจารณาที่ความถี่สูง	37
3.4 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำในภาพที่ 3.1 เมื่อพิจารณาที่ความถี่สูง	38
3.5 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับตัวต้านทานในภาพที่ 3.2 เมื่อพิจารณาที่ความถี่สูง	40

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.6 ค่าส่งผ่านความนำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง I_B	34
4.1 โครงสร้างภายในของ CCCCTA ที่ใช้ในการจำลองการทำงาน	42
4.2 ค่าอิมพีแดนซ์อินพุตและเฟสของวงจรมหาในภาพที่ 3.1	43
4.3 ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมหาในภาพที่ 3.1 เมื่อเปลี่ยนค่ากระแสไบอัส I_{B1}	43
4.4 ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันในวงจรมหาแบบตัวเหนี่ยวนำในภาพที่ 3.1	43
4.5 ค่าอิมพีแดนซ์อินพุตและเฟสของวงจรมหาในภาพที่ 3.2	44
4.6 ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมหาในภาพที่ 3.2 เมื่อเปลี่ยนค่ากระแสไบอัส I_{B2}	44
4.7 ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมหาในภาพที่ 3.2 เมื่อเปลี่ยนค่ากระแสไบอัส I_{B1}	45
4.8 วงจรมหาแบบตัวเหนี่ยวนำที่ใช้ในการทดลองจริง	45
4.9 วงจรมหาแปลงแรงดันให้เป็นกระแส	46
4.10 สัญญาณ v_m เทียบกับ v_A ของวงจรมหาในภาพที่ 4.8 ที่ความถี่ (ก) 500 Hz (ข) 1kHz	46
4.11 วงจรมหาแบบตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับตัวต้านทานที่ใช้ในการทดลองจริง	47
4.12 สัญญาณ v_m เทียบกับ v_A ของวงจรมหาในภาพที่ 4.11 ที่ความถี่ (ก) 2kHz (ข) 3kHz	47
4.13 การประยุกต์ใช้งานวงจรมหาแบบตัวเหนี่ยวนำในวงจรมหาเรโซแนนซ์ขนาน RLC	48
4.14 ผลตอบสนองทางความถี่ของ I_{LP} , I_{BP} และ I_{HP} ของวงจรมหาในภาพที่ 4.13	48
4.15 ผลตอบสนองทางความถี่ของ I_{BP} ของวงจรมหาในภาพที่ 4.13 เมื่อเปลี่ยนแปลง I_{B1}	48
4.16 วงจรมหาประยุกต์ใช้งานวงจรมหาแบบตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับตัวต้านทาน ในภาพที่ 3.2 ในวงจรมหากรองความถี่สูงผ่าน	49
4.17 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรมหาในภาพที่ 4.16	49
4.18 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรมหาในภาพที่ 4.16 เมื่อเปลี่ยนแปลง I_{B1}	49